

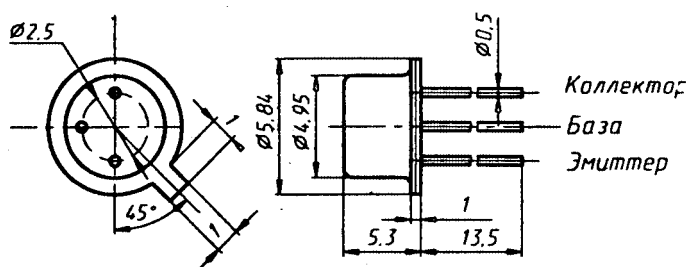
## КТ3117А, КТ3117Б, КТ3117А1

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *n-p-n* импульсные. Предназначены для применения в импульсных и переключающих устройствах. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами (КТ3117А, КТ3117Б) и в пластмассовом корпусе с гибкими выводами (КТ3117А1). Тип прибора указывается на корпусе и в этикетке.

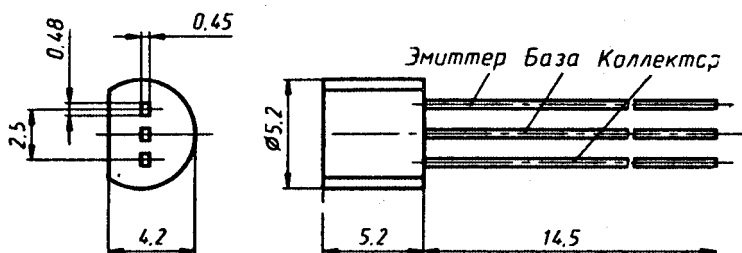
Масса транзистора в металлостеклянном корпусе не более 0,4 г, в пластмассовом корпусе не более 0,3 г.

Изготовитель — завод «Транзистор», г. Минск.

КТ3117(А Б).



КТ3117А1



### Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при  $U_{кз} = 5$  В,  $I_b = 200$  мА:

$T = +25$  °С:

КТ3117А, КТ3117А1 ..... 40...200

КТ3117Б ..... 100...300

$T = T_{мин}$ :

КТ3117А, КТ3117А1 ..... 15...200

$T = T_{макс}$ :

КТ3117А, КТ3117А1 ..... 30...350

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при  $U_{кз} = 10$  В,  $I_k = 30$  мА, не менее ..... 200 МГц

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер при  $I_k = 500$  мА,  $I_b = 50$  мА, не более ..... 0,6 В

Напряжение насыщения база—эмиттер при  $I_k = 500$  мА,  $I_b = 50$  мА, не более ..... 1,2 В

Время включения при  $I_k = 500$  мА,  $I_b = 50$  мА для КТ3117Б, не более ..... 35 нс

Время рассасывания при $I_k = 500$ мА, $I_b = 50$ мА, не более .....	80 нс
Емкость коллекторного перехода при $U_{кб} = 10$ В, не более .....	10 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{эб} = 0$ , не более .....	80 пФ
Обратный ток коллектора при $U_{кб} = 60$ В, не более:	
$T = +25$ °С .....	10 мкА
$T = T_{\text{макс}}$ .....	100 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{эб} = 4$ В, не более .....	5 мкА

### Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—база:	
КТ3117А, КТ3117А1 .....	60 В
КТ3117Б .....	75 В
Постоянное напряжение коллектор—эмиттер:	
$R_{бэ} = 0$ :	
КТ3117А, КТ3117А1 .....	60 В
КТ3117Б .....	75 В
$R_{бэ} = 1$ кОм:	
КТ3117А, КТ3117А1 .....	50 В
КТ3117Б .....	65 В
Постоянное напряжение эмиттер—база .....	4 В
Импульсное напряжение эмиттер—база при $t_n = 1$ мкс, $Q = 2$ .....	5 В
Постоянный ток коллектора .....	400 мА
Импульсный ток коллектора при $t_n = 10$ мкс, $Q = 10$ .....	800 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллек- тора <sup>1</sup> :	
$T = +40$ °С .....	300 мВт
$T = +85$ °С .....	180 мВт
Импульсная рассеиваемая мощность коллек- тора <sup>1</sup> при $t_n = 10$ мкс, $Q = 10$ :	
$T = +40$ °С .....	800 мВт
$T = +85$ °С .....	400 мВт
Тепловое сопротивление:	
переход—среда .....	0,35 °С/мВт
переход—корпус .....	0,1 °С/мВт
Температура р-п перехода .....	+150 °С
Температура окружающей среды .....	-45...+85 °С

<sup>1</sup> При  $T$  от +40 до +85 °С максимально допустимые постоянные и импульсные рассеиваемые мощности коллектора уменьшаются линейно.